

关键指标

频率: 12~17GHz
 功率增益: 25dB
 1dB 压缩点输出功率: 34dBm
 饱和输出功率: 35.5dBm
 功率附加效率: 35%
 电压/静态电流: +6V/1000mA, Vg: -0.65V
 芯片尺寸: 2.9mm×2.5mm

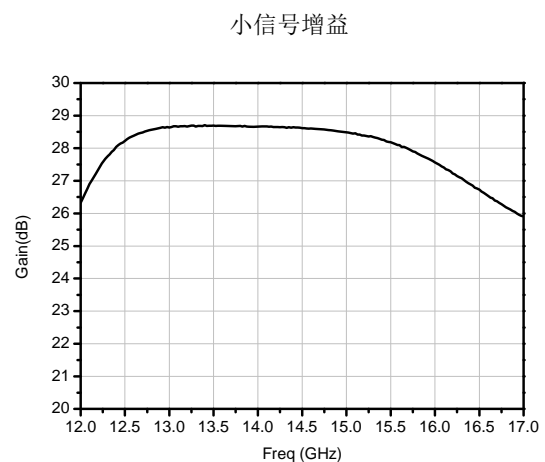
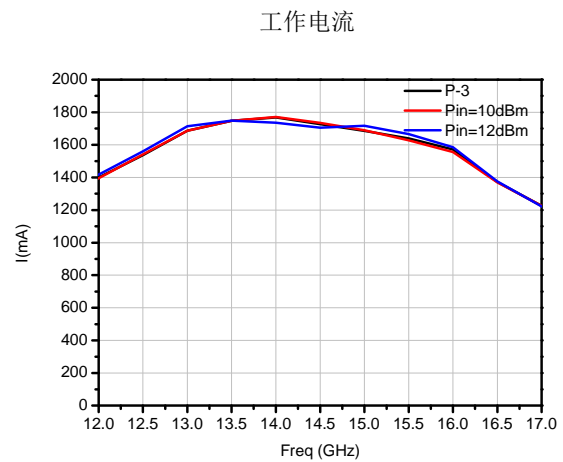
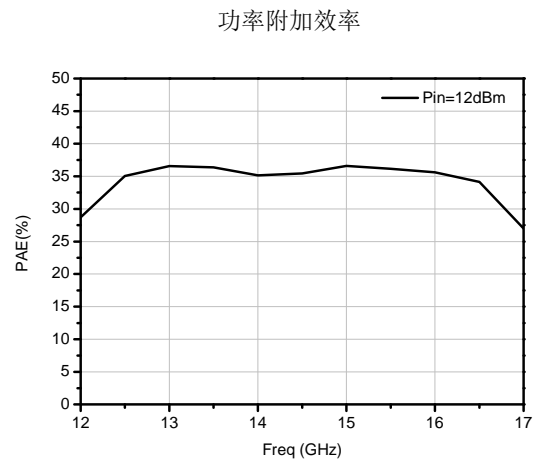
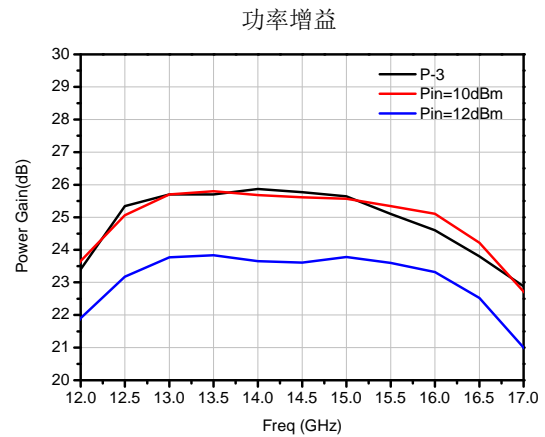
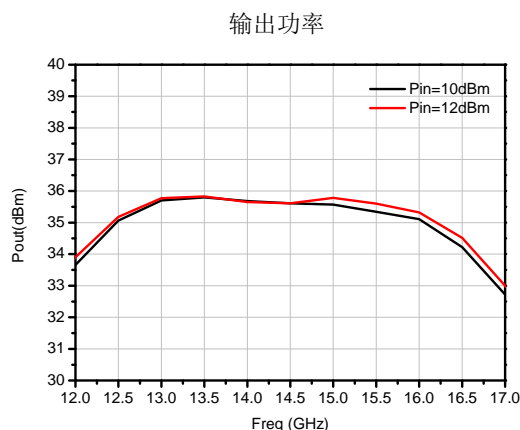
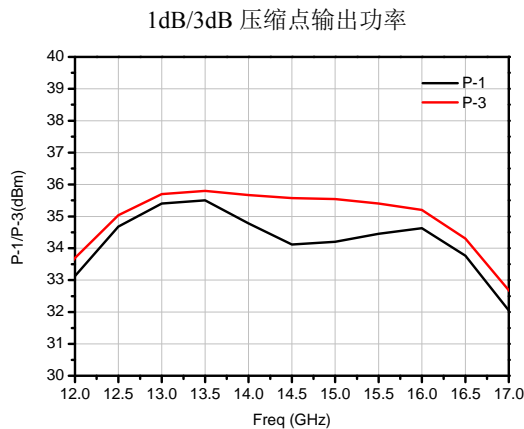
产品简介

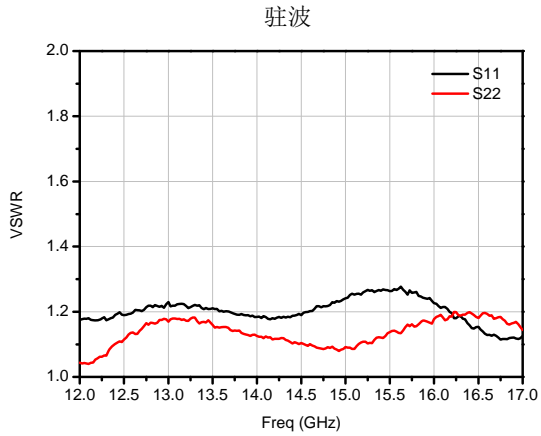
HG136F10 功率放大器芯片, 采用 GaAs pHEMT 工艺制作, 采用平衡式结构, 具有良好的驻波匹配。双电源供电, 静态电流为 1000mA, 输入输出端均集成有隔直电容。

电性能 (T_A=25°C, V_{dd}=+6V, V_g=-0.65V)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	12~17		
功率增益(dB)	-	25	-
输入/输出驻波	-	1.2/1.1	-
1dB 压缩点输出功率(dBm)	-	34	-
饱和输出功率(dBm)	-	35.5	-
功率附加效率(%)	-	35	-
静态电流(mA)	-	1000	-

典型测试曲线

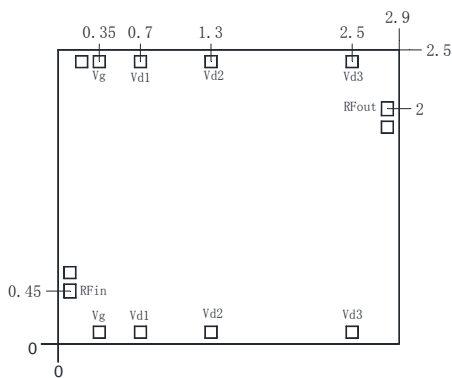




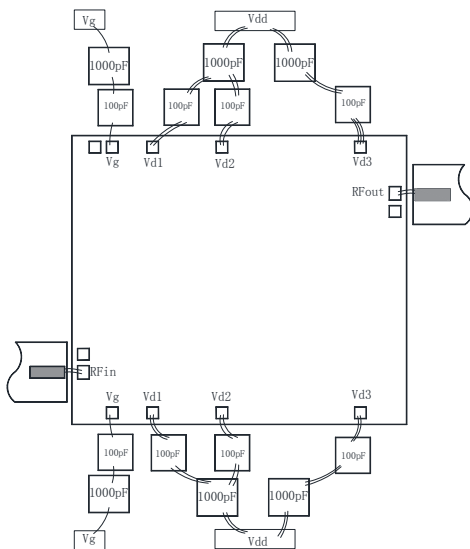
注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。

外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

工作电压	+7V
最大输入功率	+18dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃